

СОДЕРЖАНИЕ

Том 48, номер 4, 2019

МАТЕРИАЛЫ

- Влияние состава на диэлектрические свойства и перенос заряда
в 2D материалах $\text{GaS}_{1-x}\text{Se}_x$
С. М. Асадов, С. Н. Мустафаева, В. Ф. Лукичев, Д. Т. Гусейнов 243

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

- Оценка взаимосвязи скорости атомно-слоевого осаждения тонких пленок
металлов платиновой группы и молекулярной массы реагентов-предшественников
В. Ю. Васильев 249
- Возможности управления концентрацией примесей в приповерхностных
слоях пленок, выращенных методом ALD
А. В. Фадеев, К. В. Руденко 263
- Атомно-слоевое осаждение пленок нитрида кремния на арсениде галлия
с применением тлеющего разряда
Ю. К. Ежовский, С. В. Михайловский 272
- Влияние добавки N_2 на скорость травления GaAs в плазме CF_2Cl_2
С. А. Пивоваренок 279

ИЗБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ “ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ” ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ

- Синтез схемы функционального контроля на основе спектрального R-кода
с разбиением выходов на группы
*А. Л. Стемпковский, Д. В. Тельнухов, Т. Д. Жукова, А. И. Деменева,
В. В. Надоленко, С. И. Гуров* 284
- Механизмы возникновения нестабильных тиристорных эффектов в КМОП ИС
*А. И. Чумаков, Д. В. Бобровский, А. А. Печенкин, Д. В. Савченков,
Г. С. Сорокоумов, И. И. Швецов-Шиловский* 295
- Мемристорный генератор последовательности импульсов
В. В. Ракитин, С. Г. Русаков 300

ПРИБОРЫ

- Микропотребляющие усилители мощности на нитриде галлия
для диапазона частот 8–12 ГГц
*С. А. Гамкрелидзе, Д. Л. Гнатюк, А. В. Зуев, М. В. Майтама,
П. П. Мальцев, А. О. Михалев, Ю. В. Федоров* 308
- Межприборные радиационно-индуцированные утечки в объемной
КМОП технологии 180 нм
*А. Б. Боруздина, Ю. М. Герасимов, Н. Г. Григорьев, А. В. Кобыляцкий,
А. В. Уланова, И. И. Швецов-Шиловский* 315